東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター（CIES）
特任助教公募

1. 募集人員

特任助教　1 名

2. 所属

東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター（CIES）

3. 研究分野・業務内容

文部科学省の研究開発プロジェクト「COPELNIX」において、GaN（窒化ガリウム）パワーデバイスに関する計算科学的研究に従事する特任助教を募集します。

本研究では、第一原理計算を中心とした計算科学的手法を用いて、GaN パワーデバイスの性能や信頼性を支配する原子・電子レベルの物理機構の解明を目指します。

具体的には、以下の研究課題に取り組みます。

- GaN 中の不純物・点欠陥・複合欠陥の原子構造および電子状態の解析
- イオン注入に伴う欠陥形成およびその熱的安定性の解明
- GaN および関連材料の界面電子状態と電荷捕獲機構の解析
- GaN パワーデバイスの高性能化・高信頼性化に向けた材料物性の理論的研究
- 実験研究者との連携による計算結果の検証およびデバイス開発への展開

研究テーマの詳細は、採用者の専門性や経験を考慮して決定します。

4. 応募資格

以下の条件を満たす方。

1. 博士の学位を有する方、または同等の能力のある方
2. 物理学、材料科学、計算科学、応用物理学、または関連分野の研究経験を有する方
3. 理論的・計算科学的研究に意欲を持ち、実験研究者と協力して研究を推進できる方

第一原理計算（密度汎関数理論：DFT）の経験は問いません。

物性物理学、計算物理学、理論物理学、素粒子物理学などの分野からの応募も歓迎します。

第一原理計算に必要な知識・技術は、着任後に習得することが可能です。

5. 着任時期

2027 年 4 月 1 日を希望します（応相談）。

6. 任期

3 年間（予定）。

7. 給与・待遇

年俸 500 万円程度。

給与・勤務条件等は、東北大学の規程に基づき、経験・能力等を考慮して決定します。

8. 勤務地

東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター（CIES）

宮城県仙台市

9. 提出書類

1. 履歴書（写真付き）
2. 研究業績リスト
3. これまでの研究概要（A4 用紙 2 枚程度）
4. 着任後の研究に対する抱負（A4 用紙 1 枚程度）
5. 応募者について照会可能な方 2 名の氏名・所属・連絡先

10. 選考方法

書類審査および面接により選考します。

面接はオンラインで実施する場合があります。

11. 応募締切

2026 年 12 月 28 日（月）必着

12. 応募書類提出先・問い合わせ先

東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター

教授　白石 賢二

E-mail：kenji.shiraishi.c2@tohoku.ac.jp

応募書類は電子メールにて提出してください。